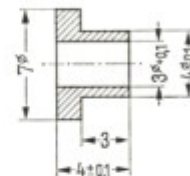


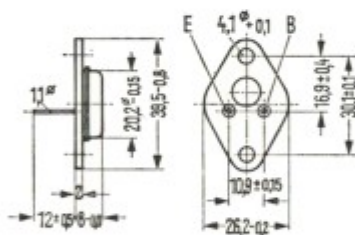
BU 110**NPN-Leistungsschalt-Transistor
für Fernseh-Horizontal-Ablenk-Endstufen**

BU 110 ist ein dreifach-diffundierter NPN-Silizium-Hochstromschalttransistor im Gehäuse 3 A 2 DIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor ist besonders für den Einsatz in Horizontal-Ablenk-Endstufen nach dem Pumptransistorprinzip geeignet.

| Typ | Bestellnummer |
|------------------------|---------------|
| BU 110 | Q62702-U83 |
| Glimmerscheibe | Q62901-B11-A |
| Isoliernippel (Teflon) | Q62901-B13-C |

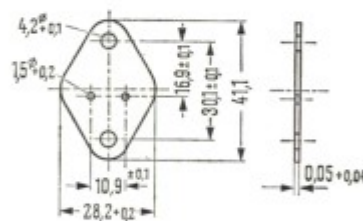


Isoliernippel (Teflon)
für Temp. bis 200 °C
Maßstab 2 : 1



Gewicht etwa 16,5 g

Maße in mm



Glimmerscheibe

Grenzdaten

Kollektor-Emitterspannung
Kollektor-Basisspannung
Emitter-Basisspannung
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung ($T_G \leq 75^\circ\text{C}$)

| | | |
|------------------|-----|----|
| U_{CEO} | 150 | V |
| U_{CBS} | 330 | V |
| U_{EBS} | 6 | V |
| $I_{C\max}$ | 8 | A |
| $I_{B\max}$ | 2,5 | A |
| T_j | 150 | °C |
| T_s | 150 | °C |
| P_{tot} | 25 | W |

Wärmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse

| | | |
|--------------|----------|------|
| $R_{th\ JG}$ | ≤ 3 | °C/W |
|--------------|----------|------|



BU 110

Statische Kenndaten ($T_U = 25^\circ\text{C}$)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

($I_{\text{CEO}} = 20\text{ mA}$) $U_{(\text{BR})\text{CEO}} > 150\text{ V}$

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

($I_{\text{CBS}} = 1\text{ mA}$) $U_{(\text{BR})\text{CBS}} > 330\text{ V}$

Kollektor-Emitter-Reststrom

($U_{\text{CES}} = 330\text{ V}; T_U = 150^\circ\text{C}$) $I_{\text{CES}} < 15\text{ mA}$

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung

($I_{\text{C}} = 6\text{ A}; I_{\text{B}} = 0,75\text{ A}$) $U_{\text{CEsat}} < 1,5\text{ V}$

Basis-Emitter-Sättigungsspannung

($I_{\text{C}} = 6\text{ A}; I_{\text{B}} = 0,75\text{ A}$) $U_{\text{BEsat}} < 1,5\text{ V}$

Statische Stromverstärkung

($I_{\text{C}} = 6\text{ A}; U_{\text{CE}} = 1,5\text{ V}$) $B > 8$ Dynamische Kenndaten ($T_U = 25^\circ\text{C}$)

Transitfrequenz

($I_{\text{C}} = 200\text{ mA}; U_{\text{CE}} = 10\text{ V}$) $f_T = 15\text{ MHz}$

Schaltzeit

($I_{\text{C}} = 6\text{ A}; I_{\text{B1}} = I_{\text{B2}} = 1\text{ A}; U_{\text{CE}} = 12\text{ V}$) $t_f = 1\text{ }\mu\text{s}$ 